

製品概要

NTMFD4C20N: デュアル N チャンネル・ パワー MOSFET 30V

技術情報は、データシートをご参照ください。

デュアル N チャンネル、パワー MOSFET、30 V、ハイサイド 18 A / ローサイド 27 A、デュアル N チャンネル SO8FL

特長

- Co-Packaged Power Stage Solution to Minimize Board Space
- Minimized Parasitic Inductances
- Optimized Devices to Reduce Power Losses
- RoHS Compliant

アプリケーション

- DC-DC Converters
- System Voltage Rails
- Point of Load

電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS(S)}^{(BR)}$ Min (V)	V_{GS} Max (V)	$V_{GS(th)}$ Max (V)	I_D Max (A)	P_D Max (W)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 2.5$ V (mΩ)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 4.5$ V (mΩ)	$R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 10$ V (mΩ)	Q_g Typ @ $V_{GS} = 4.5$ V (nC)	Q_g Typ @ $V_{GS} = 10$ V (nC)	C_{iss} Typ (pF)	Package Type
NTMFD4C20NT1G	0.4667	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	N-Channel	Dual	30	20	2.1	18.2	1.88	-	Q1: 10.8 , Q2: 5.2	Q1: 7.3 , Q2: 3.4	9.7	9.3	Q1: 970, Q2: 1950	SO-8FL Dual / DFN-8

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

6/22/2021 作成